

**КВС111А2,Б2,В2,Г2,Д2**

**ЭПИТАКСИАЛЬНО – ПЛАНАРНЫЕ  
ВАРИКАПНЫЕ МАТРИЦЫ**

аАО.336.762.ТУ/05

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТОЙ НАСТРОЙКИ РАДИОПРИЁМНИКОВ.  
Изготавливается в корпусе **КТ-26 (ТО-92)**



1-Анод 2-Катод 3-Анод

**ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**

Параметры	Обо-знач.	Ед. измер.	Режимы измерения	Min.	Max.
Общая ёмкость варикапной матрицы КВС111А2,Б2 КВС111В2,Г2 КВС111Д2	$C_B$	пФ	$U_{обр}=4В \quad f=1МГц$ $U_{обр}=1В \quad f=1МГц$	29,7 33 29 45	36,3 36,3 37 60
Добротность варикапной матрицы КВС111А2,Б2 КВС111В2,Г2 КВС111Д2	$Q_B$		$U_{обр}=4В \quad f=50МГц$	200 150 100	- - -
Постоянный обратный ток варикапной матрицы КВС111А2,Б2,В2,Г2 КВС111Д2	$I_{OBR}$	мкА	$U_{обр}=30В$ $U_{обр}=15В$	- -	1 0,2
Коэффициент перекрытия по емкости КВС111А2,Б2,В2,Г2 КВС111Д2	$K_C$		$U_{обр}=4; 30В \quad f=1МГц$ $U_{обр}=1; 9В \quad f=1МГц$	2,1 1,9	- -
Температурный коэффициент емкости варикапной матрицы	$\alpha C_B$	$1/^\circ C (x10^{-4})$	$U_{обр}=3В$	-	5

220108, г.Минск, ул. Корженевского, 16 , УП "Завод Транзистор"

Отдел маркетинга: т/ф (10-375-17) 212-59-32

E-mail: [market@transistor.com.by](mailto:market@transistor.com.by); <http://www.transistor.by>